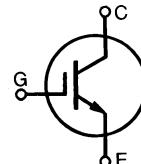
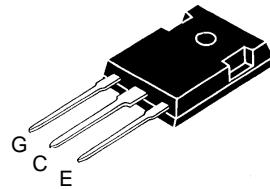
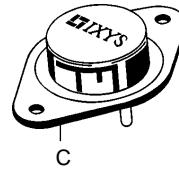


**Low $V_{CE(sat)}$ IGBT
High speed IGBT**
**IXGH/IXGM 20 N60
IXGH/IXGM 20 N60A**

V_{CES}	I_{C25}	$V_{CE(sat)}$
600 V	40 A	2.5 V
600 V	40 A	3.0 V



Symbol	Test Conditions	Maximum Ratings	
V_{CES}	$T_J = 25^\circ\text{C}$ to 150°C	600	V
V_{CGR}	$T_J = 25^\circ\text{C}$ to 150°C ; $R_{GE} = 1 \text{ M}\Omega$	600	V
V_{GES}	Continuous	± 20	V
V_{GEM}	Transient	± 30	V
I_{C25}	$T_C = 25^\circ\text{C}$	40	A
I_{C90}	$T_C = 90^\circ\text{C}$	20	A
I_{CM}	$T_C = 25^\circ\text{C}$, 1 ms	80	A
SSOA (RBSOA)	$V_{GE} = 15 \text{ V}$, $T_{VJ} = 125^\circ\text{C}$, $R_G = 82 \Omega$ Clamped inductive load, $L = 100 \mu\text{H}$	$I_{CM} = 40$ @ $0.8 V_{CES}$	A
P_c	$T_C = 25^\circ\text{C}$	150	W
T_J		-55 ... +150	$^\circ\text{C}$
T_{JM}		150	$^\circ\text{C}$
T_{stg}		-55 ... +150	$^\circ\text{C}$
M_d	Mounting torque (M3)	1.13/10	Nm/lb.in.
Weight		TO-204 = 18 g, TO-247 = 6 g	
Maximum lead temperature for soldering 1.6 mm (0.062 in.) from case for 10 s		300	$^\circ\text{C}$

TO-247 AD (IXGH)

TO-204 AE (IXGM)


G = Gate, C = Collector,
E = Emitter, TAB = Collector

Symbol	Test Conditions	Characteristic Values		
		($T_J = 25^\circ\text{C}$, unless otherwise specified)	min.	typ.
BV_{CES}	$I_C = 250 \mu\text{A}$, $V_{GE} = 0 \text{ V}$	600		V
$V_{GE(th)}$	$I_C = 250 \mu\text{A}$, $V_{CE} = V_{GE}$	2.5	5	V
I_{CES}	$V_{CE} = 0.8 \cdot V_{CES}$ $V_{GE} = 0 \text{ V}$	$T_J = 25^\circ\text{C}$ $T_J = 125^\circ\text{C}$	200	μA 1 mA
I_{GES}	$V_{CE} = 0 \text{ V}$, $V_{GE} = \pm 20 \text{ V}$		± 100	nA
$V_{CE(sat)}$	$I_C = I_{C90}$, $V_{GE} = 15 \text{ V}$	20N60 20N60A	2.5 3.0	V

Features

- International standard packages
- 2nd generation HDMOS™ process
- Low $V_{CE(sat)}$
 - for low on-state conduction losses
- High current handling capability
- MOS Gate turn-on
 - drive simplicity
- Voltage rating guaranteed at high temperature (125°C)

Applications

- AC motor speed control
- DC servo and robot drives
- DC choppers
- Uninterruptible power supplies (UPS)
- Switch-mode and resonant-mode power supplies

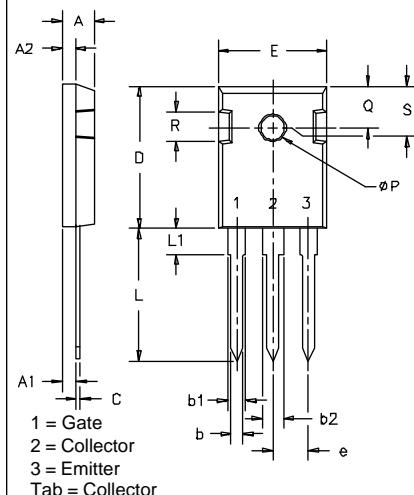
Advantages

- Easy to mount with 1 screw (TO-247) (isolated mounting screw hole)
- High power density

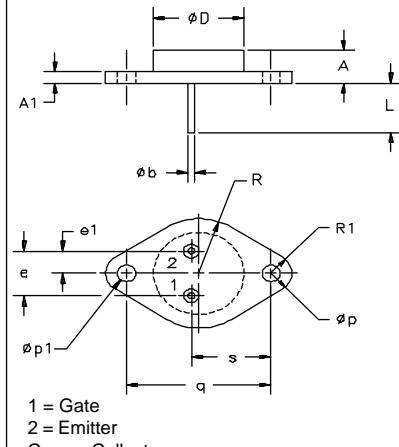
Symbol	Test Conditions	Characteristic Values			
		($T_J = 25^\circ\text{C}$, unless otherwise specified)	min.	typ.	max.
g_{fs}	$I_C = I_{C90}$; $V_{CE} = 10 \text{ V}$, Pulse test, $t \leq 300 \mu\text{s}$, duty cycle $\leq 2\%$	6	14	S	
C_{ies} C_{oes} C_{res}	$V_{CE} = 25 \text{ V}$, $V_{GE} = 0 \text{ V}$, $f = 1 \text{ MHz}$	1500	pF		
		200	pF		
		40	pF		
Q_g Q_{ge} Q_{gc}	$I_C = I_{C90}$, $V_{GE} = 15 \text{ V}$, $V_{CE} = 0.5 V_{CES}$	100	120	nC	
		20	30	nC	
		60	90	nC	
$t_{d(on)}$ t_{ri} $t_{d(off)}$ t_{fi} E_{off}	Inductive load, $T_J = 25^\circ\text{C}$ $I_C = I_{C90}$, $V_{GE} = 15 \text{ V}$, $L = 300 \mu\text{H}$ $V_{CE} = 0.8 V_{CES}$, $R_G = R_{off} = 82 \Omega$ Switching times may increase for V_{CE} (Clamp) $> 0.8 \cdot V_{CES}$, 20N60A higher T_J or increased R_G 20N60A	100	ns		
		200	ns		
		600	ns		
		200	ns		
		1.5	mJ		
$t_{d(on)}$ t_{ri} E_{on} $t_{d(off)}$ t_{fi} E_{off}	Inductive load, $T_J = 25^\circ\text{C}$ $I_C = I_{C90}$, $V_{GE} = 15 \text{ V}$, $L = 300 \mu\text{H}$ $V_{CE} = 0.8 V_{CES}$, $R_G = R_{off} = 82 \Omega$ Remarks: Switching times may increase for V_{CE} (Clamp) $> 0.8 \cdot V_{CES}$, higher T_J or increased R_G 20N60A 20N60A	100	ns		
		200	ns		
		2	mJ		
		900	1500	ns	
		530	2000	ns	
		250	600	ns	
R_{thJC} R_{thCK}		3.2	mJ		
		2.0	mJ		

IXGH 20N60 and IXGH 20N60A characteristic curves are located on the IXGH 20N60U1 and IXGH 20N60AU1 data sheets.

TO-247 AD Outline



TO-204AE Outline



IXYS reserves the right to change limits, test conditions, and dimensions.

IXYS MOSFETs and IGBTs are covered by one or more of the following U.S. patents: 4,835,592 4,881,106 5,017,508 5,049,961 5,187,117 5,486,715 4,850,072 4,931,844 5,034,796 5,063,307 5,237,481 5,381,025



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помошь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помошь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.